ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Влияние высоты вертикального кремниевого солнечного элемента на эффективность

А. Э. Атамуратов*, Б. К. Жумабаев, М.М. Халиллоев, Ш. Рахманова, Н. Д. Аминбоева, Х. Ш. Сапаров

Ургенческий государственный университет, ул. Х Олимжана, 14, Ургенч, Узбекистан

* e-mail: atabek.atamuratov@urdu.uz

Аннотация

В данной работе моделируется кремниевый двухпереходный вертикальный солнечный элемент с использованием TCAD. Рассматривается заивимость эффективности, тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и фактора заполнения от высоты солнечного элемента. Наблюдаются немонотонная скачкообразная зависимость эффективности от высоты солнечного элемента. Подробно объясняются причины наблюдаемой немонотонной зависимости на основе зависимости скорости оптической генерации от высоты солнечного элемента.

Ключевые слова: солнечный элемент, туннельный переход, концентраторная система, солнечная концентрация, эффективность солнечного элемента.

Введение

Одной из основных задач развития солнечных элементов является повышение его эффективности и уменьшение себестоимости. Для решения этой задачи предлагаются использовать различные новые полупроводниковые материалы, в частности органические материалы и сравнительно новый тип полупроводников-перовскиты. Хотя предлагаемые новые материалы являются более дешевыми и сравнительно простой технологией получения, они обладают различными существенными недостатками в связи с чем до сих пор большое внимание уделяется увеличению эффективности СЭ на основе кремния так как это один из наиболее исследованных полупроводниковых материалов и наиболее используемых при производстве солнечных элементов. Кроме этого с каждым годом стоимость этого материала уменьшается в связи с развитием технологии его получения.

Одной из структур СЭ на основе кремния, проявляющих высокую эффективность являются многопереходные СЭ для концентраторных систем [1], в частности вертикальные многопереходные СЭ [2,3]. Использование вертикальных многопереходных СЭ (ВМПСЭ) в концентраторных системах позволяет как увеличить эффективность СЭ так и сэкономить дорогой полупроводниковый материал. Свойства ВМПСЭ исследовались во многих работах [3,4]. В частности работах [3] рассматривалась зависимость эффективности от ширины n- и p-областей, уровня легирования базы, солнечной концентрации в кремниевом вертикальном многопереходном СЭ, а в работах [4] рассматривались свойства ВМПСЭ на основе GaAS. Зависимость эффективности от высоты СЭ также рассматривалась в некоторых работах, но детального исследования этого эффекта не проводилось. Так в работе [5] теоретически расс-матривалась зависимость тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и эффектив-ности от высоты структуры СЭ, но исследование ограничилось рассмотрением высоты до 80 мкм и рассматривалось влияние монохроматического излучения, а не всего солнечного спектра. В данной работе рассматривается зависимость эффективности вертикального двухпереходного СЭ от высоты в широком диапазоне его значений и от концентрации солнечного излучения.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Структура и параметры солнечного элемента и условия моделирования.

Рассматриваемая структура кремниевого двухпереходного вертикального СЭ показана на рис.1. Солнечные элементы в этой структуре последовательно соеденены с помощью туннельного перехода. Туннельный переход сформирован из p^{++} - n^{++} - перехода. Геометрические и физические параметры рассматриваемого СЭ представлены в таблице 1. Высота структуры варьировалась от 5 до 600 мкм.

Двухмерное моделирование проводилось с использованием TCAD Sentaurus. Была использована дифффузионно-дрейфовая транспортная модель, в модели подвижности были учтены зависмость от уровня легирования и включена рекомбинация Шокли-Рида-Холла.

Так как контакт между солнечными элементами осуществляется туннельным переходом для расчета туннельного тока использовали Band2Band модель и в SRH рекомбинационной модели использовали модель Шенка для туннелирования через ловушки. Используемая физическая модель была калиброванна сравнением J-V характеристик экспериментального [3] и моделируемого солнечного элемента с подобными параметрами (Рис. 2) хотя в экспериментальном образце контакт между p-n переходами металлический. Здесь предполагается, что в активном режиме на туннельный переход падает малое напряжение, соответствующее области туннельного тока и поэтому туннельный контакт ведет себя как омический как и в случае с СЭ с металлическими контактом между p-n переходами.

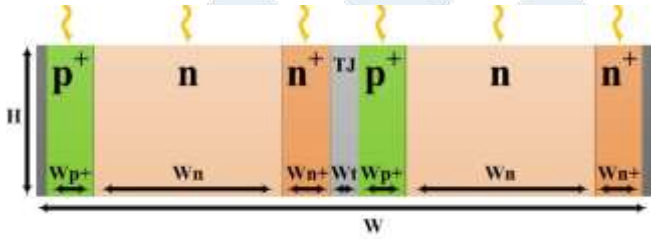


Рис.1.Структура кремниевого двухпереходного солнечного элемента с двумя p-n переходами соединенными туннельным переходом. Геометрические размеры структуры приведены в таблице 1.

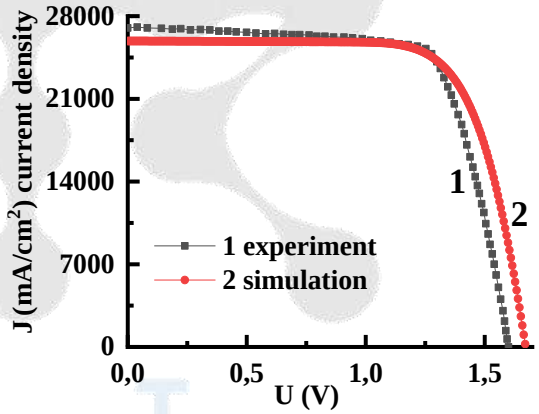


Рис.2.J-V характеристика экспериментального и моделируемого вертикального солнечного элемента с двумя p-n переходами с одинаковыми параметрами.

Table 1. Геометрические параметры и уровни легирования моделируемого ВМПСЭ.

Результаты моделирования и их обсуждение.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

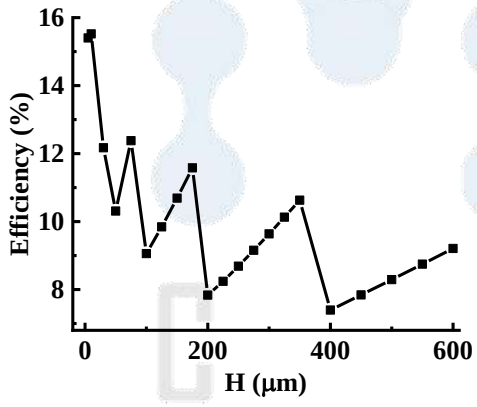
VOLUME-5, ISSUE-4

Результаты моделирования показывают, что эффективности ВМПСЭ в основном уменьшается с увеличением высоты структуры, но имеет при этом скачкообразный характер (рис. 2. а). Для анализа такого поведения рассматривались зависимости Isc, Uoc, FF от высоты структуры H СЭ. Согласно формуле эффективности (1) для вертикального СЭ приведенного в [6] она кроме указанных выше величин, зависит также от высоты и толщины структуры:

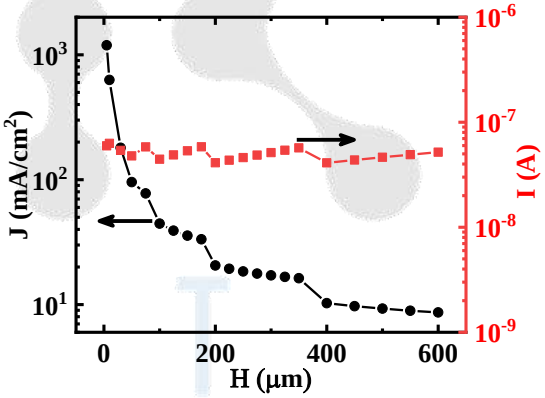
$$\eta = \frac{J_{sc} \cdot V_{oc} \cdot FF \cdot H}{P_{in} \cdot W} \qquad (1)$$

где P_{in} есть мощность падающего солнечного излучения на единицу площади, W ширина структуры солнечного элемента.

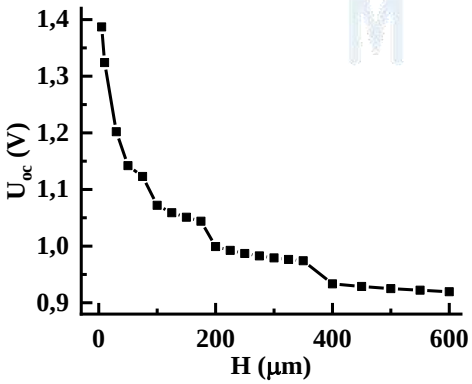
Согласно (1) уменьшение эффективности в основном определяется уменьшением плотности тока короткого замыкания, который в рассматриваемом диапазоне высот уменьшается на несколько порядков, в то время как фактор заполнения FF увеличивается всего на несколько процентов. Напряжение холостого хода также уменьшается способствуя уменьшению эффективности. Уменьшение плотности тока вызывается увеличением площади сечения перпендикулярного направлению тока связанным с увеличением высоты. Скачкообразный же характер зависимости эффективности в основном определяется зависимостью тока короткого замыкания от высоты элемента (рис.2 б). Такое поведение I_{sc} определяется зависимостью скорости оптической генерации от высоты солнечного элемента (рис.3). Эта зависимость построена из зависимости скорости оптической генерации в структуре от длины волны солнечной радиации при различных высотах солнечного элемента. Очевидно, такая зависимость скорости оптической генерации



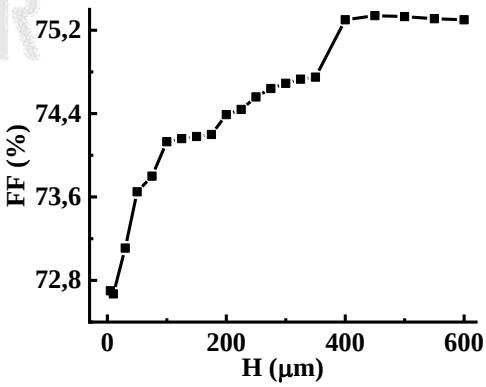
a



b



c



d

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Рис.2 Зависимость эффективности (a), плотности тока и тока (b), напряжения холостого хода (c) и фактора заполнения (d) от высоты СЭ.

обусловлена как зависимостью глубины поглощения от длины волны [24] так и формой спектра солнечной радиации [14].

На рис. 2 видно, что зависимость плотности тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и FF от высоты имеет ступенчатый характер в то время как зависимость эффективности от высоты имеет резко выраженный скачкообразный характер. Согласно формуле (1) это связано с “усиливающим” эффектом высоты H. Это можно увидеть при сравнении зависимостей приведенной эффективности $J_{sc}V_{oc}FF/P_{in}$ и эффективности от высоты H на рис.4.

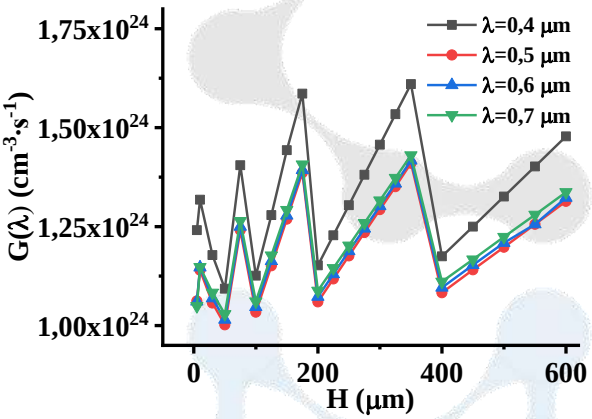


Рис. 3. Зависимость скорости оптической генерации от высоты СЭ при различных длинах волн солнечного излучения при солнечной концентрации 1 Солнце.

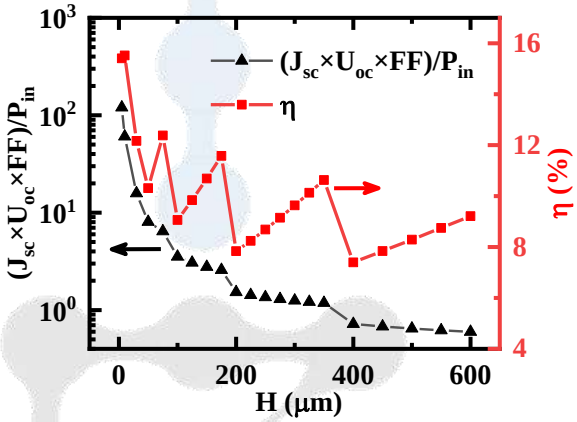


Рис. 4. Зависимость эффективности и приведенной эффективности $\frac{J_{sc}\cdot U_{oc}\cdot FF}{P_{in}}$ от высоты СЭ.

Заключение

Результаты моделирования показывают, что эффективность вертикального солнечного двухпереходного СЭ немонотонно зависит от его высоты. Особенностью эффекта высоты является то что при изменении высоты эффективность может сильно варьироваться. Так при изменении высоты между 200 и 400 мкм эффективность может увеличиться примерно до 6%, что является очень существенным увеличением. Поэтому расчет оптимальной высоты вертикального СЭ является очень важным фактором при разработке вертикальных СЭ.

Список использованных источников:

[1] M. Ochoa, E. Barrigón, L. Barrutia, I. García, I. Rey-Stolle, and C. Algora, “Limiting factors on the semiconductor structure of III–V multijunction solar cells for ultra-high concentration (1000–5000 suns),” Prog. Photovolt., Res. Appl., vol. 24, no. 10, pp. 1332–1345, 2016, doi: 10.1002/pip.2791.

[2] A. Gover and P. Stella, “Vertical multijunction solar-cell one dimensional analysis,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-21, no. 6, pp. 351–356, Jun. 1974, doi: 10.1109/T-ED.1974.17927.

ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, 2022-2.889, 2023-5.384, 2024-6.875 ResearchBib IF: 9.948 / 2024

VOLUME-5, ISSUE-4

[3] B. L. Sater and N. D. Sater, "High voltage silicon VMJ solar cells for up to 1000 suns intensities," in Proc. Conf. Rec. 29th IEEE Photovolt. Spec. Conf., May 2002, pp. 1019–1022, doi: 10.1109/PVSC.2002.1190778.

[4] Outes C., Fernández E.F., Seoane N., Almonacid F., García-Loureiro A.J.: Dependence of the vertical-tunnel-junction GaAs solar cell on concentration and temperature. IET Renew. Power Gener. 1–12 (2022). https://doi.org/10.1049/rpg2.12456,

[5] Gokhan Sahin, Genber Kerimli. Effect of the depth base along the vertical on the electrical parameters of a vertical parallel silicon solar cell in open and short circuit. Results in Physics Volume 8, March 2018, Pages 257-261

[6] A.E. Atamuratov, B.Q. Jumaboyev, A.E. Abdikarimov, A. Yusupov, A.G.J. Loureiro, 14th Spanish Conference on Electron Devices, CDE 2023 - Proceedings2023 14th Spanish Conference on Electron Devices, CDE 2023, Valencia, 6 June 2023